

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de recocción superficial de un sustrato que comporta un revestimiento, comprendiendo dicho procedimiento:

- El desfile del sustrato (1) que comporta el revestimiento (2) a recocer bajo una lámpara flash (4) que emite una luz intensa pulsada, estando la cara del sustrato que comporta dicho revestimiento orientada hacia la lámpara flash,
- La irradiación del revestimiento a recocer por la luz intensa pulsada emitida por la lámpara flash a través de una máscara (3) situada, en una posición fija con respecto a la lámpara flash, entre la lámpara flash y el revestimiento a recocer, y que comporta una ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la dirección de desfile del sustrato, estando reguladas la frecuencia de la lámpara flash y la velocidad de desfile del sustrato de manera que cada punto del revestimiento a recocer reciba al menos un impulso luminoso,

caracterizado por el hecho de que

la distancia entre la cara inferior de la máscara y la superficie del revestimiento a recocer es como máximo igual a 1mm, preferentemente como máximo igual a 500um, idealmente como máximo igual a 100um,

Y por el hecho de que la forma y la extensión de la ranura son

tales que la máscara oculta el revestimiento a recocer en todas las zonas en donde la intensidad luminosa que, en ausencia de máscara, llegaría a nivel del revestimiento a recocer es inferior a una intensidad luminosa umbral, denominada en adelante intensidad luminosa nominal.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la ranura posee una forma sensiblemente rectangular.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por el hecho de que la frecuencia de la lámpara flash, el ancho de la ranura y la velocidad de desfile son tales que al menos 90%, preferentemente al menos 95%, más preferentemente al menos 98% de los puntos del revestimiento a recocer reciban un solo impulso luminoso.

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el largo de la ranura es sensiblemente igual al ancho del revestimiento a recocer.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el ancho del revestimiento a recocer es de al menos igual a 1m, preferentemente al menos igual a 2m, en particular al menos

igual a 3m.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el ancho de la ranura está entre 1 y 50cm, preferentemente entre 5 y 20cm.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la velocidad de desfile del sustrato que comporta el revestimiento a recocer está comprendida entre 0,1 y 30m/minuto, preferentemente entre 1 y 20m/minuto, y en particular entre 2 y 10m/minuto.

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el revestimiento a recocer comporta al menos una capa de un metal, preferentemente una capa de plata, o al menos una capa de óxido conductor transparente.

9. Aparato para la recocción superficial de un sustrato que comporta

- una lámpara flash (4) capaz de emitir una luz intensa pulsada,
- un medio de transporte (6) que permite hacer desfilar un sustrato plano (1) que comporta un revestimiento a recocer (2) por delante de la lámpara flash,
- una máscara (3) situada, en una posición fija con respecto

a la lámpara flash y el medio de transporte, comportando dicha máscara una ranura cuyo eje longitudinal es perpendicular a la dirección de desfile del sustrato, y que está posicionada de manera que la luz emitida por la lámpara flash sea proyectada a través de la ranura en dirección del sustrato plano que comporta un revestimiento a recocer,

caracterizado por el hecho de que comporta medios de regulación de la distancia entre la máscara y el medio de transporte tales, que la distancia entre la cara inferior de la máscara y la superficie del revestimiento a recocer pueda ser ajustada a un valor inferior a 1mm, preferentemente inferior a 500um, en particular inferior a 100um.